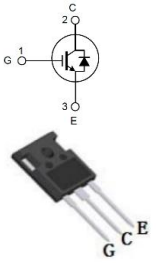
TRW5065CH1 是 50A，650V 高可靠性 IGBT，具有高速开关特性、及低导通损耗和开关损耗等特点。

1.主要特征

封装类型：



TO-247

- 50A,650V , VCE(sat)=1.8V @IC=50A
- 饱和压降为正温度系数，易于并联使用
- 低导通损耗
- 内置 SiC 二极管
- 高速开关特性
- 高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性

2.极限参数（除非另有说明 , TA = 25°C)：

符号	参数	参数范围	单位
V_{CE}	集电极—发射极电压	650	V
V_{GE}	栅极-发射极电压	±20	V
I_C	集电极电流（T_C=25°C)	80	A
	集电极电流（T_C=100°C)	50	A
I_{Cpulse}	集电极脉冲电流	150	A
I_F	二极管正向电流(T_j=150°C)	20	A
P_{tot}	耗散功率（T_C=25°C)	259	W
	耗散功率（T_C=100°C)	129	W

参数	V_{CE}	$V_{CE(sat)}$	V_F	$T_{j,Max}$	Eon	Eoff
值	650V	1.8V	1.5V	175°C	1.6mJ	1.2mJ

3.产品应用

- UPS 电源、PFC 电源
- 大功率电源等领域